

WEST



Generate Collection

L19: Entry 5 of 9

File: DWPI

Feb 20, 1998

DERWENT-ACC-NO: 1998-199371

DERWENT-WEEK: 199818

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Substrate processing apparatus for plasma etching, plasma- CVD, plasma ashing - has load lock chamber between cassette loader chamber and reaction process chamber which are mutually lead through air- tight gate valves, to hold multiple wafers before processing

PATENT-ASSIGNEE: KOKUSAI DENKI KK (KOKZ)

PRIORITY-DATA: 1996JP-0223022 (August 5, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 10050802 A	February 20, 1998		017	H01L021/68

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 10050802A	August 5, 1996	1996JP-0223022	

INT-CL (IPC): B65 G 1/00; H01 L 21/02; H01 L 21/68

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10050802A

BASIC-ABSTRACT:

The apparatus has a cassette loading chamber (10) led to a load lock chamber (52) through a first air-tight gate valve (62). A cassette conveyance robot (20) carries cassette from load chamber to load lock chamber. The loading chamber and the load lock chamber are mutually isolated air-tightly by the operation of first gate valve during processing. The load lock chamber is led to a processing chamber (56) through a conveyance chamber (54) and gate valves (64,66).

The load lock chamber and the processing chamber are isolated air-tightly by the operation of the valves during processing. The load lock chamber holds more than double the number of wafers held in processing chamber. The various chambers are coupled by coupling modules (300).

ADVANTAGE - Increases through-put. Increases efficiency. Simplifies maintenance and occupies less area.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10050802A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/13

DERWENT-CLASS: Q35 U11 V05 X14

EPI-CODES: U11-C09C; U11-C09M; U11-F02A2; V05-F05C; V05-F08D1; V05-F08E1; X14-F02;

(51) Int.Cl. [®]	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 01 L 21/68			H 01 L 21/68	A
B 65 G 1/00	535		B 65 G 1/00	535
H 01 L 21/02			H 01 L 21/02	Z

審査請求 未請求 請求項の数26 FD (全 17 頁)

(21)出願番号	特願平8-223022	(71)出願人	000001122 国際電気株式会社 東京都中野区東中野三丁目14番20号
(22)出願日	平成8年(1996)8月5日	(72)発明者	須田 敏彦 東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際電気株式会社内
		(72)発明者	豊田 一行 東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際電気株式会社内
		(72)発明者	巻口 一誠 東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際電気株式会社内
		(74)代理人	弁理士 宮本 治彦

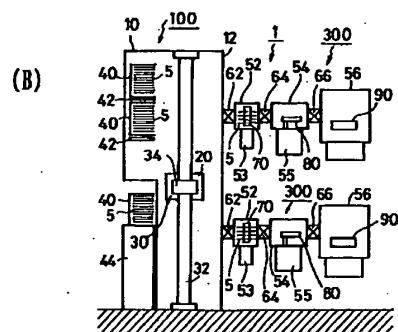
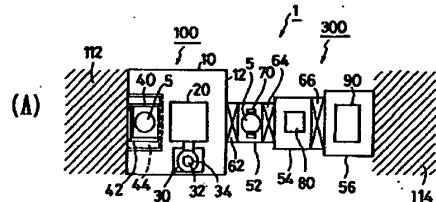
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】高い基板処理効率が得られ、スループットの優れた基板処理装置を提供する。

【解決手段】カセットローダ室10にカセット搬送兼ウェーハ搬送ロット20を設け、その室壁12に連結モジュール300を取り外し可能に取り付ける。連結モジュール300を互いに離間して鉛直方向に積み重ねる。各連結モジュール300では、外ゲートバルブ62、ロードロック室52、ゲートバルブ64、搬送室54、ゲートバルブ66及び反応処理室56をカセットローダ室10からこの順に連結配置する。ロードロック室52内のウェーハポート70の構造を反応処理室56内で同時に処理されるウェーハ5の枚数の2倍以上の枚数を保持可能なものとする。搬送室54内にウェーハ搬送ロット80を設ける。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板搬送部と、

前記基板搬送部に取り付けられた複数のモジュールと、前記基板搬送部内に設けられた第1の基板搬送手段であって、基板を前記複数のモジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、を備える基板処理装置であって、前記複数のモジュールのそれぞれが、

前記基板を処理する気密構造の基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた気密構造の中間室と、前記基板処理室と前記中間室との間に設けられた第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記中間室との間を気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第1のバルブと、前記中間室と前記基板搬送部との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には前記中間室と前記基板搬送部との間を気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第2のバルブとを備え、

前記中間室には前記基板を保持可能な基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記基板処理室のそれぞれにおいて一度に処理される前記基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であり、前記中間室または前記基板処理室には、前記基板を前記基板保持手段と前記基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】前記複数のモジュールのそれぞれが、

前記基板を処理する前記基板処理室であって真空的に気密な構造の前記基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた前記中間室であって真空的に気密な構造の前記中間室と、前記基板処理室と前記中間室との間に設けられた前記第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記中間室との間を真空的に気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な前記第1のバルブと、

前記中間室と前記基板搬送部との間に設けられた前記第2のバルブであって閉じた場合には前記中間室と前記基板搬送部との間を真空的に気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な前記第2のバルブとを備えることを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】前記基板処理室と前記中間室とが互いに独立して減圧可能であることを特徴とする請求項2記載の基板処理装置。

【請求項4】前記第2の基板搬送手段が前記中間室に設けられていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項5】前記基板保持手段が前記第2の基板搬送手

2

段よりも前記基板搬送部側に設けられていることを特徴とする請求項4記載の基板処理装置。

【請求項6】基板搬送部と、前記基板搬送部に取り付けられた複数のモジュールと、前記基板搬送部内に設けられた第1の基板搬送手段であって、基板を前記複数のモジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、を備える基板処理装置であって、前記複数のモジュールのそれぞれが、

前記基板を処理する気密構造の基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた気密構造の中間室と、

10 前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた気密構造の第1および第2の中間室であって、前記基板処理室側の前記第1の中間室と、前記基板搬送部側の前記第2の中間室と、前記基板処理室と前記第1の中間室との間に設けられた第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記第1の中間室との間を気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第1のバルブと、

前記第1の中間室と前記第2の中間室との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には前記第1の中間室と前記第2の中間室との間を気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第2のバルブと、

前記第2の中間室と前記基板搬送部との間に設けられた第3のバルブであって閉じた場合には前記第2の中間室と前記基板搬送部との間を気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第3のバルブとを備え、

前記第2の中間室には、前記基板を保持可能な基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記基板処理室のそれぞれにおいて一度に処理される前記基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であり、前記第1の中間室には、前記基板を前記基板保持手段と前記基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項7】前記複数のモジュールのそれぞれが、前記基板を処理する前記基板処理室であって真空的に気密な構造の前記基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられ、真

40 空的に気密な構造の前記第1および第2の中間室であって、前記基板処理室側の前記第1の中間室と、前記基板搬送部側の前記第2の中間室と、

前記基板処理室と前記第1の中間室との間に設けられた前記第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記第1の中間室との間を真空的に気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な前記第1のバルブと、

前記第1の中間室と前記第2の中間室との間に設けられた前記第2のバルブであって閉じた場合には前記第1の

50 中間室と前記第2の中間室との間を真空的に気密にする

ことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通つて移動可能な前記第2のバルブと、前記第2の中間室と前記基板搬送部との間に設けられた前記第3のバルブであって閉じた場合には前記第2の中間室と前記基板搬送部との間を真空的に気密にすることができる、開いた場合には前記基板がその内部を通つて移動可能な前記第3のバルブとを備えることを特徴とする請求項6記載の基板処理装置。

【請求項8】前記基板処理室、前記第1の中間室および前記第2の中間室が互いに独立して減圧可能であることを特徴とする請求項7記載の基板処理装置。

【請求項9】前記基板処理室に前記基板を保持可能な第2の基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記第2の基板保持手段よりも少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項10】前記基板保持手段が、前記基板処理室で処理される前の基板を保持する処理前基板保持部と、前記基板処理室で処理された後の基板を保持する処理済基板保持部であって前記処理前基板保持部とは異なる前記処理済基板保持部とを備えることを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項11】前記基板処理室が、複数枚の前記基板を同時に処理可能な基板処理室であることを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項12】前記第2の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能であることを特徴とする請求項11記載の基板処理装置。

【請求項13】前記第2の基板搬送手段が、前記基板処理室のそれぞれにおいて一度に処理される前記基板の枚数と同じ枚数の前記基板を同時に搬送可能であることを特徴とする請求項12記載の基板処理装置。

【請求項14】前記第1の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能であることを特徴とする請求項1乃至13のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項15】前記基板搬送部が大気圧下で前記基板を搬送する基板搬送部であることを特徴とする請求項1乃至14のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項16】前記基板処理室が減圧下で前記基板の処理を行う基板処理室であることを特徴とする請求項15記載の基板処理装置。

【請求項17】前記第1の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能であって、前記複数枚の基板間のピッチを可変であることを特徴とする請求項16記載の基板処理装置。

【請求項18】前記基板保持手段が耐熱性の基板保持手段であることを特徴とする請求項1乃至17のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項19】前記基板保持手段が、複数の前記基板を鉛直方向に積層して保持可能であることを特徴とする請

求項1乃至18のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項20】前記基板保持手段を昇降可能な昇降手段をさらに備えることを特徴とする請求項19記載の基板処理装置。

【請求項21】前記基板保持手段が複数の前記基板を鉛直方向に積層して保持可能であり、前記基板処理装置が、プラズマを利用して前記基板の処理を行うプラズマ処理装置であり、前記基板処理装置が複数の前記基板を横に並べて保持可能な第2の基板保持手段を備え、前記第2の基板搬送手段が前記基板保持手段と前記第2の基板保持手段との間で前記基板を搬送可能であることを特徴とする請求項1乃至20のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項22】前記複数のモジュールが互いに離間して鉛直方向に積み重ねられ、前記複数のモジュールのそれぞれが取り外し可能に前記基板搬送部に取り付けられていることを特徴とする請求項1乃至21のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項23】複数の前記基板を収容可能なカセットを保持するカセット保持手段が前記基板搬送部にさらに設けられ、前記第1の基板搬送手段が前記カセット保持手段に保持される前記カセットと前記複数のモジュールとの間で前記基板を搬送可能であることを特徴とする請求項1乃至22のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項24】前記第1の基板搬送手段が前記カセットを搬送可能な構造を有していることを特徴とする請求項23記載の基板処理装置。

【請求項25】前記第1の基板搬送手段を昇降可能な昇降機をさらに前記基板搬送部に備えることを特徴とする請求項1乃至24のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項26】前記基板搬送部が、前記カセット保持手段と異なる所定の高さに設けられたカセット投入部であって、前記カセットを前記基板搬送部内に投入および/または前記基板搬送部外に前記カセットを搬出する前記カセット投入部をさらに備えることを特徴とする請求項25記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は基板処理装置に関するもので、特に半導体ウェーハ処理装置に関し、そのなかでも特に、プラズマエッキング装置、プラズマCVD(Chemical Vapor Deposition)装置、プラズマアッキング装置等、プラズマを利用して半導体ウェーハを処理する半導体ウェーハ処理装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】図13は、従来のプラズマを利用した半導体ウェーハ処理装置のうち、プラズマCVD装置500の一例を示した平面図である。

【0003】搬送ロット570を内蔵したロードロッカ室510の周辺にはゲート弁562、564、566

および542をそれぞれ介して反応処理室552、554および556ならびにカセット室520の各ユニットが設置されている。それぞれのユニットは気密構造になっており、カセット室520にはカセット530を出し入れするための外ゲート弁544がゲート弁542とは別に設けられている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】このような構造のプラズマCVD装置500では、カセット室520と反応処理室552、554、556との間での半導体ウェーハ5の搬送はロードロック室510の搬送ロボット570のみによって行っていたので、半導体ウェーハ5の処理効率を向上させることは困難であった。スループットを稼ぐためにはロードロック室510をさらに多角形として反応処理室552、554、556を増す必要があるが、このようにすると、搬送ロボット570による搬送が基板処理速度をますます律速するようになり、やはり半導体ウェーハ5の処理効率を向上させることは困難であった。

【0005】従って、本発明の目的は、高い基板処理効率が得られ、スループットの優れた基板処理装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、基板搬送部と、前記基板搬送部に取り付けられた複数のモジュールと、前記基板搬送部内に設けられた第1の基板搬送手段であって、基板を前記複数のモジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、を備える基板処理装置であって、前記複数のモジュールのそれぞれが、前記基板を処理する気密構造の基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた気密構造の中間室と、前記基板処理室と前記中間室との間に設けられた第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第1のバルブと、前記中間室と前記基板搬送部との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には前記中間室と前記基板搬送部との間を気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第2のバルブとを備え、前記中間室には前記基板を保持可能な基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記基板処理室のそれにおいて一度に処理される前記基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であり、前記中間室または前記基板処理室には、前記基板を前記基板保持手段と前記基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられていることを特徴とする第1の基板処理装置が提供される。

【0007】本発明のこの第1の基板処理装置においては、基板処理室をそれぞれ備える複数のモジュールが基板搬送部に取り付けられているから、その分、基板処理

の効率を高めることができる。

【0008】そして、本発明の第1の基板処理装置は、基板を各モジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、各モジュールに設けられた基板保持手段と、各モジュールに設けられ、基板保持手段と基板処理室との間で基板を搬送可能な第2の基板搬送手段とを備えているから、各モジュールへの基板搬送と、各モジュール内での基板搬送とを独立したものとすることができ、その結果、基板搬送を効率よく行えるようになる。

【0009】さらに、このように、各モジュールの中間室には基板保持手段と基板処理室との間で基板を搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられているので、他のモジュールの基板処理室における処理状態とは無関係に基板処理室に基板を搬入でき基板処理室から基板を搬出できる。基板として、例えば半導体ウェーハを使用する場合には、基板処理室内における基板の加熱時間は、半導体ウェーハ内の不純物の分布状態等に影響を与え、それがひいては半導体デバイスの特性に影響を与えるので、一定にする必要があるが、本発明においては、各モジュールに基板処理室と基板搬送手段とがそれぞれ設けられているから、他の基板処理室での処理状態とは無関係に基板を搬出でき、その結果、各モジュールにおいて基板が加熱される時間をそれぞれ一定に保つことができる。

【0010】さらに、複数のモジュールのそれぞれが、基板を処理する気密構造の基板処理室と、基板処理室と基板搬送部との間に設けられた気密構造の中間室と、基板処理室と中間室との間に設けられた第1のバルブであって、閉じた場合には基板処理室と中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には基板がその内部を通り移動可能な第1のバルブと、中間室と基板搬送部との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には中間室と基板搬送部との間を気密にすことができ、開いた場合には基板がその内部を通り移動可能な第2のバルブとを備えているから、各モジュールの中間室と基板処理室とをそれぞれ独立して気密に保つことができて、各モジュール内および各モジュール間ににおいて中間室と基板処理室とを独立して所定のガス雰囲気や真空雰囲気にすことができ、しかも、基板処理室と中間室との間および中間室と基板搬送部との間をそれぞれ基板が移動できる。そして、このように中間室と基板処理室とを独立して気密に保つことができるので、中間室はロードロック室として機能させることができ。なお、このような第1のバルブとしては、好ましくはゲートバルブが用いられる。

【0011】そして、中間室に設けられる基板保持手段が、基板処理室のそれぞれにおいて一度に処理される基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であるので、基板処理室で基板を処理している間に予め中間室の基板保持手段に次に処理すべき基板を保持しておくことができ、基板処理室から基板保持手段に処理後

の基板を取り出した後、すぐに次の基板処理のための基板を基板処理室に供給できる。その結果、基板を効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0012】また、第2の基板搬送手段に加えて基板保持手段をさらに設けることにより、基板の保持機能と搬送機能とを分離することができるようになり、例えば、ある基板を基板保持手段で保持して冷却等を行っている間に他の基板を基板搬送手段で基板処理室に搬送することができるようになり、より効率的に基板の処理を行うことができるようになる。

【0013】好ましくは、前記複数のモジュールのそれぞれが、前記基板を処理する前記基板処理室であって真空的に気密な構造の前記基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた前記中間室であって真空的に気密な構造の前記中間室と、前記基板処理室と前記中間室との間に設けられた前記第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記中間室との間を真空的に気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通じて移動可能な前記第1のバルブと、前記中間室と前記基板搬送部との間に設けられた前記第2のバルブであって閉じた場合には前記中間室と前記基板搬送部との間を真空的に気密にすることことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通じて移動可能な前記第2のバルブとを備える。

【0014】このようにすれば、各モジュールの中間室と基板処理室とをそれぞれ独立して真空的に気密に保つことができて、各モジュール内および各モジュール間ににおいて中間室と基板処理室とを独立して所定の真空雰囲気にしてることができ、しかも、基板処理室と中間室との間および中間室と基板搬送部との間をそれぞれ基板が移動できる。そして、このように中間室と基板処理室とを独立して真空的に気密に保つことができるので、中間室を真空用のロードロック室として機能させることができる。

【0015】そして、このような真空的に気密な構造の中間室または基板処理室には基板を保持可能な基板保持手段と基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられているので、各モジュールへの基板の搬送は基板搬送部に設けられた第1の基板搬送手段によって大気圧下で行い、真空中での基板の搬送は各モジュールの中間室または基板処理室に設けられた第2の基板搬送手段で行うようにすることができる。従って、基板を搬送する機構を設ける領域を全て真空的に気密な構造とする必要がなくなり、各モジュールに基板を搬送する基板搬送部は大気圧下で搬送を行う領域とすることができ、真空的に気密な構造の領域は各モジュールの中間室や基板処理室に分割することができる。その結果、基板搬送部の構造や第1の基板搬送手段の構造を簡単なものとすることことができ、安価に製作できるようになる。また、各

モジュールの中間室のそれぞれの容積も小さくなり、その壁の厚みを薄くしても強度が保てるようになり、その結果、安価に製作できるようになる。さらに、中間室または基板処理室に設けられた第2の基板搬送手段においても、その鉛直方向の昇降動作を必要最小限に抑えることができるので、その制作費も安価なものとなり、また、真空的に気密な構造の中間室内または基板処理室内において第2の基板搬送手段の駆動部から発生する可能性のあるパーティクルも最小限に抑えることができる。

10 【0016】そして、例えば、各モジュールに基板を搬送する基板搬送部は大気圧下で搬送を行う領域とし、基板処理室においては減圧下で基板の処理を行う場合を考えると、本発明の第1の基板処理装置においては、中間室に設けられる基板保持手段が、基板処理室のそれぞれにおいて一度に処理される基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であるので、基板処理室で減圧下で基板を処理している間に予め中間室を大気圧状態として基板保持手段に次に処理すべき基板を保持し、その後中間室を減圧にして待機しておくことができる。

20 従って、基板処理室において基板の処理が終わって所定の減圧状態となれば、すぐに第1のバルブを開けて基板保持手段に処理後の基板を取り出すことができ、その後、すぐに、次の基板処理のための基板を基板処理室に供給できる。その結果、基板を効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0017】また、このように基板処理室と中間室が共に真空的に気密な構造であるので、基板処理室と中間室とが減圧可能であることが好ましいが、その場合には、さらに好ましくは、基板処理室と中間室とを互いに独立して減圧可能とする。

【0018】また、好ましくは、前記第2の基板搬送手段が前記中間室に設けられている。

【0019】また、好ましくは、前記基板保持手段が前記第2の基板搬送手段よりも前記基板搬送部側に設けられている。

【0020】このようにすれば、基板搬送部の第1の基板搬送手段と中間室の第2の基板搬送手段との間にこの基板保持手段が位置することになり、この基板保持手段を介して、第1の基板搬送手段と第2の基板搬送手段との間で効率的に基板の受け渡しができるようになる。

40 【0021】また、本発明によれば、基板搬送部と、前記基板搬送部に取り付けられた複数のモジュールと、前記基板搬送部内に設けられた第1の基板搬送手段であって、基板を前記複数のモジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、を備える基板処理装置であって、前記複数のモジュールのそれぞれが、前記基板を処理する気密構造の基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられた気密構造の第1および第2の中間室であって、前記基板処理室側の前記第1の中間室と、前記基板搬送部側の前記第2の中間室と、前記基板処理室

と前記第1の中間室との間に設けられた第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記第1の中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第1のバルブと、前記第1の中間室と前記第2の中間室との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には前記第1の中間室と前記第2の中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第2のバルブと、前記第2の中間室と前記基板搬送部との間に設けられた第3のバルブであって閉じた場合には前記第2の中間室と前記基板搬送部との間を気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な第3のバルブと、前記第2の中間室には、前記基板を保持可能な基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記基板処理室のそれれにおいて一度に処理される前記基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であり、前記第1の中間室には、前記基板を前記基板保持手段と前記基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられていることを特徴とする第2の基板処理装置が提供される。

【0022】本発明のこの第2の基板処理装置においては、基板処理室をそれぞれ備える複数のモジュールが基板搬送部に取り付けられているから、その分、基板処理の効率を高めることができる。

【0023】そして、本発明の第2の基板処理装置は、基板を各モジュールに搬送可能な第1の基板搬送手段と、各モジュールに設けられた基板保持手段と、各モジュールに設けられ、基板保持手段と基板処理室との間で基板を搬送可能な第2の基板搬送手段とを備えているから、各モジュールへの基板搬送と、各モジュール内での基板搬送とを独立したものとすことができ、その結果、基板搬送を効率よく行えるようになる。

【0024】さらに、このように、各モジュールの第1の中間室には基板保持手段と基板処理室との間で基板を搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられているので、他のモジュールの基板処理室における処理状態とは無関係に基板処理室に基板を搬入でき基板処理室から基板を搬出できる。このように、各モジュールに基板処理室と基板搬送手段とがそれぞれ設けられているから、他の基板処理室での処理状態とは無関係に基板を搬出でき、その結果、各モジュールにおいて基板が加熱される時間をそれぞれ一定に保つことができる。

【0025】さらに、複数のモジュールのそれぞれが、基板を処理する気密構造の基板処理室と、基板処理室と基板搬送部との間に設けられた気密構造の第1および第2の中間室であって、基板処理室側の第1の中間室と、基板搬送部側の第2の中間室と、基板処理室と第1の中間室との間に設けられた第1のバルブであって閉じた場合には基板処理室と第1の中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には基板がその内部を通って移動

可能な第1のバルブと、第1の中間室と第2の中間室との間に設けられた第2のバルブであって閉じた場合には第1の中間室と第2の中間室との間を気密にすことができ、開いた場合には基板がその内部を通って移動可能な第2のバルブと、第2の中間室と基板搬送部との間に設けられた第3のバルブであって閉じた場合には第2の中間室と基板搬送部との間を気密にすことができ、開いた場合には基板がその内部を通って移動可能な第3のバルブとを備えているから、各モジュールの第1の中間室と第2の中間室と基板処理室とをそれぞれ独立して気密に保つことができて、各モジュール内および各モジュール間において第1の中間室と第2の中間室と基板処理室とを独立して所定のガス雰囲気や真空雰囲気にすことができ、しかも、基板処理室と第1の中間室との間、第1の中間室と第2の中間室との間および第2の中間室と基板搬送部との間をそれぞれ基板が移動できる。そして、このように第1および第2の中間室と基板処理室とを独立して気密に保つことができるので、第2の中間室はロードロック室として機能させることができる。な

20 お、このような第1および第2のバルブとしては、好ましくはゲートバルブが用いられる。

【0026】そして、第2の中間室に設けられる基板保持手段が、基板処理室のそれれにおいて一度に処理される基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であるので、基板処理室で基板を処理している間に予め第2の中間室の基板保持手段に次に処理すべき基板を保持しておくことができ、基板処理室から基板保持手段に処理後の基板を取り出した後、すぐに次の基板処理のための基板を基板処理室に供給できる。その結果、

30 基板を効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0027】また、第2の基板搬送手段に加えて基板保持手段をさらに設けることにより、基板の保持機能と搬送機能とを分離することができるようになり、例えば、ある基板を基板保持手段で保持して冷却等を行っている間に他の基板を基板搬送手段で基板処理室に搬送することができるように、より効率的に基板の処理を行うことができるようになる。

【0028】この第2の基板処理装置において、好ましくは、前記複数のモジュールのそれぞれが、前記基板を処理する前記基板処理室であって真空的に気密な構造の前記基板処理室と、前記基板処理室と前記基板搬送部との間に設けられ、真空的に気密な構造の前記第1および第2の中間室であって、前記基板処理室側の前記第1の中間室と、前記基板搬送部側の前記第2の中間室と、前記基板処理室と前記第1の中間室との間に設けられた前記第1のバルブであって閉じた場合には前記基板処理室と前記第1の中間室との間を真空的に気密にすことができ、開いた場合には前記基板がその内部を通って移動可能な前記第1のバルブと、前記第1の中間室と前記第

11

2の中間室との間に設けられた前記第2のバルブであつて閉じた場合には前記第1の中間室と前記第2の中間室との間を真空的に気密にすることができる、開いた場合には前記基板がその内部を通じて移動可能な前記第2のバルブと、前記第2の中間室と前記基板搬送部との間に設けられた前記第3のバルブであつて閉じた場合には前記第2の中間室と前記基板搬送部との間を真空的に気密にすることができる、開いた場合には前記基板がその内部を通じて移動可能な前記第3のバルブとを備える。

【0029】このようにすれば、各モジュールの第1の中間室と第2の中間室と基板処理室とをそれぞれ独立して真空的に気密に保つことができて、各モジュール内および各モジュール間において第1の中間室と第2の中間室と基板処理室とを独立して所定の真空雰囲気にすることができる、しかも、基板処理室と第1の中間室との間、第1の中間室と第2の中間室との間および第2の中間室と基板搬送部との間をそれぞれ基板が移動できる。そして、このように第1、第2の中間室と基板処理室とを独立して真空的に気密に保つことができるので、第2の中間室を真空用のロードロック室として機能させることができる。

【0030】そして、このような真空的に気密な構造の第1の中間室には基板を保持可能な基板保持手段と基板処理室との間で搬送可能な第2の基板搬送手段が設けられているので、各モジュールへの基板の搬送は基板搬送部に設けられた第1の基板搬送手段によって大気圧下で行い、真空中での基板の搬送は各モジュールの第1の中間室に設けられた第2の基板搬送手段で行うようにすることができる。従って、基板を搬送する機構を設ける領域を全て真空的に気密な構造とする必要がなくなり、各モジュールに基板を搬送する基板搬送部は大気圧下で搬送を行なう領域とすることことができ、真空的に気密な構造の領域は各モジュールの第1の中間室に分割することができる。その結果、基板搬送部の構造や第1の基板搬送手段の構造を簡単なものとすることができます、安価に製作できるようになる。また、各モジュールの第1の中間室のそれらの容積も小さくなり、その壁の厚みを薄くしても強度が保てるようになり、その結果、安価に製作できるようになる。さらに、第1の中間室に設けられた第2の基板搬送手段においても、その鉛直方向の昇降動作を必要最小限に抑えることができるので、その制作費も安価なものとなり、また、真空的に気密な構造の第1の中間室内において第2の基板搬送手段の駆動部から発生する可能性のあるパーティクルも最小限に抑えることができる。

【0031】なお、同じく真空的に気密な構造である第2の中間室も各モジュールにそれぞれ設けられているので、それらの容積も小さくなり、その壁の厚みも薄くしても強度が保てるようになり、その結果、安価に製作できるようになる。

12

【0032】また、本発明の第2の基板処理装置においては、基板処理室と第1の中間室と第2の中間室とが共に真空的に気密な構造である場合には、基板処理室と第1の中間室と第2の中間室とが減圧可能であることが好ましいが、その場合には、さらに好ましくは、基板処理室と第1の中間室と第2の中間室とを互いに独立して減圧可能とする。

【0033】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、前記基板処理室に前記基板を保持可能な第2の基板保持手段が設けられ、前記基板保持手段が前記第2の基板保持手段よりも少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能であることが好ましく、このようにすれば、第2の中間室に設けられる基板保持手段が、基板処理室のそれらにおいて一度に処理される基板の枚数の少なくとも2倍以上の枚数の基板を保持可能となり、基板処理室で基板を処理している間に予め第2の中間室の基板保持手段に次に処理すべき基板を保持しておくことができ、基板処理室から基板保持手段に処理後の基板を取り出した後、すぐに次の基板処理のための基板を基板処理室に供給でき、その結果、基板を効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0034】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記基板保持手段が、前記基板処理室で処理される前の基板を保持する処理前基板保持部と、前記基板処理室で処理された後の基板を保持する処理済基板保持部であつて前記処理前基板保持部とは異なる前記処理済基板保持部とを備える。

【0035】このようにすれば、基板処理室で基板を処理している間に予め第2の中間室の基板保持手段の処理前基板保持部に次に処理すべき基板を保持しておくことができ、基板処理室から取り出した処理後の基板は基板保持手段の処理済基板保持部に保持できるから、処理後の基板を取り出して処理済基板保持部に保持した後、すぐに次の基板処理のための基板を処理前基板保持部から基板処理室に供給でき、その結果、基板を効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0036】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記基板処理室が、複数枚の前記基板を同時に処理可能な基板処理室である。このようにすれば、基板の処理効率が向上し、スループットが向上する。

【0037】そして、この場合に、好ましくは、前記第2の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能である。このようにすれば、基板の搬送効率が向上し、スループットが向上する。

【0038】この場合に、さらに好ましくは、この前記第2の基板搬送手段が、前記基板処理室のそれらにおいて一度に処理される前記基板の枚数と同じ枚数の前記

基板を同時に搬送可能である。このようにすれば、基板の搬送効率が向上し、スループットが向上する。

【0039】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記第1の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能である。このようにすれば、基板の搬送効率が向上し、スループットが向上する。

【0040】本発明の第1および第2の基板処理装置は、前記基板搬送部が大気圧下で前記基板を搬送する基板搬送部である場合に好適に使用される。

【0041】基板搬送部が大気圧下で基板を搬送する基板搬送部であると、基板搬送部に設けられる第1の基板搬送手段の構造が簡単なものとなり、安価に製造できるようになる。加えて、基板搬送部も気密構造のチャンバーの中に設ける必要がなく、筐体で覆えばよくなるので、構造が簡単となり、製造費も低減することができる。

【0042】そして、本発明の第1および第2の基板処理装置は、前記基板搬送部が大気圧下で前記基板を搬送する基板搬送部であって、前記基板処理室が減圧下で前記基板の処理を行う基板処理室である場合に、特に有効に機能する。

【0043】この場合に、好ましくは、前記第1の基板搬送手段が、複数枚の前記基板を同時に搬送可能であって、前記複数枚の基板間のピッチを可変である。

【0044】基板処理室内で複数枚の基板を同時に処理するためには、例えば、成膜等を行う場合にあっては、占有床面積を小さくするための基板を積層して基板の処理を行うことが行われるが、この場合には、複数枚の基板の間隔を基板処理室内でのガスの流れ等を考慮して膜厚均一性等を維持することができる間隔にする必要がある。一方、工場内において基板を搬送する場合には、カセット等が用いられることが多いが、通常は、このカセットの溝間隔は上記膜厚均一性等を維持することができる間隔とは異なっている。そのために、いずれかの場所で基板間のピッチを変換することが必要となる。

【0045】従って、上述のように、前記第1の基板搬送手段が複数枚の基板を同時に搬送可能であって複数枚の基板間のピッチを可変であるようにすれば、第1の基板搬送手段が設けられる基板搬送部は大気圧下で前記基板を搬送する基板搬送部であるので、この第1の基板搬送手段は大気圧下で用いるものとなり、基板間のピッチを可変にしても、真空下での場合と比較すれば構造が簡単であり、安価に製造でき、また、パーティクルの発生を抑えることができる。そして、このように第1の搬送手段で基板間のピッチを変換できるので、第1の中間室に設けられる第2の基板搬送手段はピッチ可変な構造とする必要がなくなり、その構造が簡単となり、安価に製造できる。なお、この場合には、第2の中間室に設けられる基板保持手段が複数枚の基板を保持可能であって、

保持される基板間の間隔を基板処理室内での基板間の間隔と実質的に等しくしておくことが好ましい。

【0046】上記のように、大気圧下で基板間のピッチを可変とし減圧下では基板間のピッチを固定して、複数枚の基板を同時に搬送するようにすれば、搬送装置の製造コストを低減でき、搬送装置の大型化が抑制され、しかもパーティクルの発生が抑制されて基板をクリーンな環境で搬送することができる。さらに、複数枚の基板を同時に搬送するので、スループットが向上し、基板間のピッチが可変であるので、基板処理室内において高精度で基板処理が行える基板間のピッチに変換できる。

【0047】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記基板保持手段が耐熱性の基板保持手段である。

【0048】このようにすれば、本発明の第1の基板処理装置における中間室、第2の基板処理装置における第1の中間室をそれぞれ、基板処理室で処理が終わった高温の基板を冷却する基板冷却室として使用できる。

【0049】なお、耐熱性の基板保持手段は、石英、ガラス、セラミックスまたは金属からなることが好ましく、このような材料から構成すれば、中間室や第1の中間室を真空中にしても、基板保持手段からアウトガス等の不純物が発生することはないので、中間室や第1の中間室の雰囲気を清浄に保つことができる。なお、セラミックスとしては、焼結させたSiCや焼結させたSiCの表面にSiO₂膜等をCVDコートしたものやアルミナ等が好ましく用いられる。

【0050】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記基板保持手段が、複数の前記基板を鉛直方向に積層して保持可能である。

【0051】この場合に、好ましくは、前記基板保持手段を昇降可能な昇降手段をさらに備える。このように、基板保持手段を昇降可能とすれば、基板保持手段と基板処理室との間で基板を搬送可能な第2の基板搬送手段には昇降機能を設けなくともよくなり、その結果、第2の基板搬送手段の構造が簡単となり、安価に製造できるようになる。

【0052】また、本発明の第1および第2の基板処理装置の基板処理室においては、好ましくは、プラズマCVD法、ホットウォールCVD法、光CVD法等の各種CVD法等による絶縁膜、配線用金属膜、ポリシリコン、アモルファスシリコン等の成膜や、エッチング、アニール等の熱処理、エピタキシャル成長、拡散等が行われる。

【0053】そして、特に好ましくは、プラズマエッチング、プラズマCVD、プラズマアッキング等、プラズマを利用して基板を処理するプラズマ処理が行われるが、この場合には、好ましくは、前記基板処理装置が複数の前記基板を横に並べて保持可能な第2の基板保持手段を備える。

【0054】このようにすれば、プラズマ処理装置の電極との距離が複数の基板間ではほぼ等しくでき、その結果、複数の基板がさらされるプラズマの密度が基板間で均一となり、基板間でプラズマ処理が均一に行えるようになる。

【0055】そして、この場合に、好ましくは、前記基板保持手段が複数の前記基板を鉛直方向に積層して保持可能であり、前記第2の基板搬送手段が前記基板保持手段と前記第2の基板保持手段との間で前記基板を搬送可能である。

【0056】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記複数のモジュールが互いに離間して鉛直方向に積み重ねられ、前記複数のモジュールのそれぞれが取り外し可能に前記基板搬送部に取り付けられている。

【0057】このように、複数のモジュールを鉛直方向に積み重ねて設けているから、モジュールを複数使用して基板の処理効率を高くしても、基板処理装置によるクリーンルームの占有面積を増加させることなく、また、装置のメンテナンス領域も増加させることがない。

【0058】さらに、このように鉛直方向に積み重ねられた複数のモジュールが、互いに離間して、それぞれが取り外し可能に基板搬送部に取り付けられているから、いずれかのモジュールにメンテナンスが必要となった場合に、メンテナンスが必要なモジュールのみを容易に取り外すことができ、そのモジュールのメンテナンスを行っている際にも他のモジュールを稼働させることができ、その結果、基板処理装置の稼働効率が大幅に向上する。

【0059】また、複数のモジュールが、互いに離間して、それぞれが取り外し可能に基板搬送部に取り付けられているから、基板搬送部に取り付けるモジュールの数を、時間当たりの必要処理枚数や処理の種類に応じて適宜選択できる。

【0060】これに対して、図13に示した従来のプラズマCVD装置500では、スループットを稼ぐために反応処理室552、554および556が3個設けられているが、より一層のスループットを得るにはロードロック室510をさらに多角形として反応処理室552、554、556を増す必要がある。スループットを稼ぐ目的で、ロードロック室510を多角形にすると、ロードロック室510が大きくなるばかりでなく、これに連結される反応処理室552、554、556のメンテナンススペース580も大きくなり、装置の占有面積は増大するばかりである。

【0061】クリーンルームを必要とする半導体製造工場においては、設備投資額及び設備の維持管理費は大きな負担となっており、この負担を軽減するために、小占有面積の装置が強く望まれている。本発明の第1および第2の基板処理装置においては、上述のように、複数の

モジュールを鉛直方向に積み重ねて設けているから、モジュールを複数使用して基板の処理効率を高くしても、基板処理装置によるクリーンルームの占有面積を増加させることなく、また、装置のメンテナンス領域も増加させることがない。

【0062】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、複数の前記基板を収容可能なカセットを保持するカセット保持手段が前記基板搬送部にさらに設けられ、前記第1の基板搬送手段が前記カセット保持手段に保持される前記カセットと前記複数のモジュールとの間で前記基板を搬送可能である。

【0063】この場合に、好ましくは、前記第1の基板搬送手段が前記カセットを搬送可能な構造を有している。

【0064】このようにすれば、第1の基板搬送手段で基板搬送手段とカセット搬送手段を兼ねることができる、基板搬送手段の昇降手段とカセット搬送手段の昇降手段とを共通化することができ、昇降装置の制作費が低減でき、また、基板搬送部の占有床面積を小さくでき、ひいては基板処理装置の占有面積を小さくできる。

【0065】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記第1の基板搬送手段を昇降可能な昇降機をさらに前記基板搬送部に備えることによって、各モジュールに第1の基板搬送手段が対応可能とする。

【0066】また、本発明の第1および第2の基板処理装置においては、好ましくは、前記基板搬送部が、前記カセット保持手段と異なる所定の高さに設けられたカセット投入部であって、前記カセットを前記基板搬送部内

30 に投入および/または前記基板搬送部外に前記カセットを搬出する前記カセット投入部をさらに備える。

【0067】半導体製造工場においては、自動搬送ロボットに対応するために、各装置においては、カセットの投入高さが決められている場合が多い。本発明の基板処理装置においては、これに対応できるように、上記のように、カセット投入部を所定の高さに設けている。この場合に、カセット投入部に投入されたカセットから各モジュール内に基板を搬送する必要が生じるが、本発明においては、第1の基板搬送手段にカセットを搬送可能な構造を設け、第1の基板搬送手段を昇降可能な昇降機を基板搬送部に備え、また、カセットを保持するカセット保持手段を基板搬送部に設けることにより、まず、複数の基板を収容するカセットを所定のカセット保持手段まで昇降機と第1の基板搬送手段によって搬送し、その後、第1の基板搬送手段によってカセットから各モジュールまで基板をそれぞれ搬送できるので、カセット投入部と各モジュールとの間の基板の搬送効率が高くなる。

【0068】なお、本発明において処理される基板としては、好ましくは半導体ウェーハが用いられ、その場合には、基板処理装置は半導体ウェーハ処理装置として機

能する。

【0069】また、基板としては、液晶表示素子用のガラス基板等を使用することもできる。

【0070】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0071】(第1の実施の形態)図1は、本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための図であり、図1Aは平面図、図1Bは断面図であり、図2、図3は、本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための断面図であり、図4、図5は、本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための平面図である。図6、図8は、本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための平面図であり、図7、図9は、本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための断面図である。

【0072】この半導体ウェーハ処理装置1として、プラズマCVD装置を例として説明する。

【0073】半導体ウェーハ処理装置1は、カセットローダユニット100と、2つの連続モジュール300とを備えている。

【0074】カセットローダユニット100は、カセットローダ室10を備え、カセットローダ室10の室壁12に、2つの連続モジュール300がそれぞれ取り外し可能に取り付けられている。また、2つの連続モジュール300は、互いに離間して鉛直方向に積み重ねられている。

【0075】このように、複数の連続モジュール300を鉛直方向に積み重ねて設けているから、連続モジュール300を複数使用してウェーハ5の処理効率を高くしても、半導体ウェーハ処理装置1によるクリーンルームの占有面積を増加させることができない。

【0076】また、半導体ウェーハ処理装置1のメンテナンス領域は、カセットローダユニット100側のメンテナンス領域112と反応処理室56側のメンテナンス領域114のみであるので、連続モジュール300を複数使用してウェーハ5の処理効率を高くしても、半導体ウェーハ処理装置1のメンテナンス領域を増加させることができない。

【0077】さらに、このように鉛直方向に積み重ねられた複数の連続モジュール300が、互いに離間して、それぞれが取り外し可能にカセットローダ室10の室壁12に取り付けられているから、いずれかの連続モジュール300にメンテナンスが必要となった場合に、メンテナンスが必要な連続モジュール300のみを容易に取り外すことができ、その連続モジュール300のメンテナンスを行っている際にも他の連続モジュール300を稼働させることができ、その結果、半導体ウェーハ処理

装置1の稼働効率が大幅に向上する。

【0078】また、複数の連続モジュール300が、互いに離間して、それぞれが取り外し可能にカセットローダ室10の室壁12に取り付けられているから、カセットローダ室10の室壁12に取り付けるモジュールの数を、時間当たりの必要処理枚数や処理の種類に応じて適宜選択でき、例えば、図2に示すように1段の構成や図3に示すように3段の構成とすることもできる。

【0079】それぞれの連続モジュール300においては、外ゲートバルブ62、ロードロック室52、ゲートバルブ64、搬送室54、ゲートバルブ66および反応処理室56がカセットローダ室10から離れるに従ってこの順に連続配置されている。

【0080】ロードロック室52、搬送室54および反応処理室56はそれぞれ真空的に気密な構造であって、それぞれ独立して所定の真空雰囲気にすることができる。

【0081】反応処理室56にはサセプタ90が設けられている。反応処理室56においてはプラズマCVDが行われる。サセプタ90は、図4に示すように、2枚の半導体ウェーハ5を横に並べて保持する構造である。

【0082】このように2枚の半導体ウェーハ5を横に並べて保持するようにすれば、プラズマ処理装置の電極との距離が2枚のウェーハ5間でほぼ等しくでき、その結果、2枚のウェーハ5がさらされるプラズマの密度が基板間で均一となり、ウェーハ5間でプラズマ処理が均一に行えるようになる。

【0083】また、反応処理室56においては2枚同時に処理するのでウェーハ5の処理効率が向上するが、反応処理室56において同時に処理するウェーハ5の枚数はウェーハ5のサイズや処理形態によって適宜選択可能であり、例えば、図5に示すように3枚のウェーハ5を横に並べて3枚同時処理とすることもできる。

【0084】搬送室54には、ウェーハ搬送ロボット80と、ウェーハ搬送ロボット80を駆動する駆動部55とが設けられている。このウェーハ搬送ロボット80はウェーハ5をウェーハポート70とサセプタ90との間で搬送可能である。

【0085】このように、各連続モジュール300の搬送室54にウェーハ5をウェーハポート70とサセプタ90との間で搬送可能なウェーハ搬送ロボット80が設けられているので、他の連続モジュール300の反応処理室56における処理状態とは無関係に反応処理室56にウェーハ5を搬入でき反応処理室56からウェーハ5を搬出できる。このように、各連続モジュール300に反応処理室56とウェーハ搬送ロボット80とがそれぞれ設けられているから、他の反応処理室56での処理状態とは無関係にウェーハ5を搬出でき、その結果、各連続モジュール300においてウェーハ5が加熱される時間50をそれぞれ一定に保つことができる。

【0086】ロードロック室52には、ウェーハポート70と、このウェーハポート70を昇降する昇降機53が設けられている。ウェーハポート70には図6乃至8に示すように4つのスロットが設けられている。このスロットは、上側の2つが反応処理前のウェーハ用であり、下側の2つが反応処理後のウェーハ用である。このように、ウェーハポート70には、搬送方向に対応したスロットの位置が割り当てられている。ウェーハポート70は、反応処理室56で同時に処理されるウェーハの枚数の2倍の枚数のウェーハ保持可能である。図6、図7は、反応処理前の2枚のウェーハが上側の2つのスロットに保持され、反応処理後の2枚のウェーハが下側の2つのスロットに保持されている様子を示している。図8、図9は上側の2枚のウェーハが反応処理室56に搬送される途中の状態を示している。

【0087】このように、ロードロック室52に設けられるウェーハポート70が反応処理室56で同時に処理されるウェーハの枚数の2倍の枚数のウェーハを保持可能であるので、反応処理室56でウェーハを処理している間に予めロードロック室52のウェーハポート70の上側の2つのスロットに次に処理すべきウェーハを保持しておくことができ、反応処理室56からウェーハポート70の下側の2つのスロットに処理後のウェーハを取り出した後、すぐに次の処理のためのウェーハを反応処理室56に供給できる。その結果、ウェーハを効率よく処理することができ、スループットを高くすることができる。

【0088】ウェーハ搬送ロボット80は、2枚のウェーハをウェーハポート70とサセブタ90との間に同時に搬送可能である。従って、反応処理室で同時に処理されるウェーハの枚数と同じ枚数のウェーハを同時に搬送可能である。このようにウェーハ搬送ロボット80は複数のウェーハを同時に搬送可能であり、そして反応処理室で同時に処理されるウェーハの枚数と同じ枚数のウェーハを同時に搬送可能であるので、ウェーハの搬送効率が向上し、スループットが向上する。

【0089】ロードロック室52には、ウェーハポート70を昇降する昇降機53が設けられているので、ウェーハ搬送ロボット80には昇降機能を設けなくとも、ウェーハポート70の所定のスロットにウェーハを搬送でき、その結果、ウェーハ搬送ロボット80の構造が簡単となり、安価に製造できるようになる。

【0090】また、ロードロック室52にはウェーハポート70を設け、搬送室54にはウェーハ搬送ロボット80を設けているから、ウェーハの保持機能と搬送機能とを分離することができるようになり、例えば、あるウェーハをウェーハポート70で保持して冷却等を行っている間に他のウェーハをウェーハ搬送ロボット80で反応処理室56に搬送することができるようになり、より効率的にウェーハの処理を行うことができる

ようになる。

【0091】また、ウェーハポート70は耐熱性であり、反応処理室56で処理が終わった高温のウェーハをウェーハポート70に保持して冷却することができる。

【0092】なお、ウェーハポート70は、石英、ガラス、セラミックスまたは金属からなることが好ましく、このような材料から構成すれば、真空中においても、ウェーハポート70からアウトガス等の不純物が発生することはないので、雰囲気を清浄に保つことができる。なお、セラミックスとしては、焼結させたSiCや焼結させたSiCの表面にSiO₂膜等をCVDコートしたもののアルミナ等が好ましく用いられる。

【0093】カセットローダ室10の内部には、カセットを保持するカセット棚が複数設けられており、複数のカセット40を保持可能である。カセットローダ室10の外部下方にはカセットローダ44が設置され、カセットローダ44は半導体ウェーハ処理装置1の外部との間でカセット40の授受が可能な機構を有する。カセット40はカセットローダ44によってカセットローダ室10に設けた所定の投入口(図示せず。)から投入される。また、このカセットローダ44には必要に応じ、カセット40に収納されたウェーハのオリエンテーションフラットを合わせる機構部を内蔵することが可能である。

【0094】カセットローダ室10の内部には、さらに、カセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20と、このカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20を昇降させるエレベータ30が設けられている。エレベータ30は、

ねじ軸32と昇降部34とを備え、昇降部34内のナット(図示せず。)とねじ軸32とによってボールねじを構成している。ねじ軸32を回転させると、昇降部34が昇降し、それに応じて昇降部34に取り付けられたカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20が、カセット投入口および2つの連結モジュール300にアクセス可能になるように昇降する。カセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20は、後に図6を参照して説明するように、カセット搬送機21とウェーハ搬送機23とを備えている。

【0095】このように、カセットローダ室10の内部にカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20を設け、2つの連結モジュール300にウェーハを搬送可能とし、連結モジュール300の搬送室54にウェーハ搬送ロボット80を設け、反応処理室56へウェーハを搬送可能としているから、各連結モジュール300へのウェーハの搬送と、各モジュール300内のウェーハの搬送とを独立したものとすることができ、その結果、ウェーハの搬送を効率よく行えるようになる。

【0096】そして、このように、真空的に気密な構造の搬送室54にはウェーハ搬送ロボット80を設け、ま

た、カセットローダ室10の内部にはカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20を設けているので、各連結モジュール300へのウェーハの搬送はカセットローダ室10のカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20によって大気圧下で行い、真空中でのウェーハの搬送は各連結モジュール300のウェーハ搬送ロボットで行うようになることができる。従って、ウェーハを搬送する機構を設ける領域を全て真空的に気密な構造とする必要がなくなり、各連結モジュール300に基板を搬送するカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20が設けられているカセットローダ室10は大気圧下で搬送を行う領域とすることができる、真空的に気密な構造の領域は各連結モジュール300に分割することができる。その結果、カセットローダ室10やカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20の構造を簡単なものとすることができる、安価に製作できるようになる。また、各連結モジュール300のロードロック室52や搬送室54のそれぞれの容積も小さくなり、その壁の厚みを薄くしても強度が保てるようになり、その結果、安価に製作できるようになる。さらに、搬送室54に設けられたウェーハ搬送ロボット80においても、その鉛直方向の昇降動作を必要最小限に抑えられるので、その制作費も安価なものとなり、また、真空的に気密な構造の搬送室54においてウェーハ搬送ロボット80の駆動部から発生する可能性のあるパーティクルも最小限に抑えることができる。

【0097】次に、ウェーハの搬送および処理方法を説明する。

【0098】カセットローダ44によってカセットローダ室10に投入されたカセット40は、カセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20上に載置されて、エレベータ30によって上側に運ばれ、その後カセット棚42上に載置される。次に、カセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20によりロードロック室52のウェーハポート70にウェーハを搭載する。本実施の形態では、2枚のウェーハを一度にカセット40からウェーハポート70の上側2つのスロットにカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20により搬送する。なお、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20によってウェーハをロードロック室52内に搬送する際には、ゲートバルブ64は閉じておき、外ゲートバルブ62は開けておく。

【0099】ロードロック室52内のウェーハポート70にウェーハを搭載した後、外ゲートバルブ62を開じ、ロードロック室52内を真空引きする。

【0100】真空引き後、ゲートバルブ64を開ける。なお、搬送室54は予め真空引きされている。

【0101】その後、2枚のウェーハは、真空中で、搬送室54内のウェーハ搬送ロボット80によりロードロック室52内のウェーハポート70から反応処理室56内のサセアタ90に搬送される。なお、この際には、ゲートバルブ66は開けられており、反応処理室56も

真空引きされている。

【0102】搬送後、ゲートバルブ66を閉じ、反応処理室56を所定の雰囲気として反応処理室56のサセアタ90に搭載された2枚のウェーハにプラズマCVDにより成膜処理を同時に行う。

【0103】このプラズマCVDにより成膜処理を行っている間に、上記と同様にして、ロードロック室52内のウェーハポート70の上側2つのスロットに未処理のウェーハを搭載しておく。

【0104】所定の成膜が行われた後は、反応処理室56を真空引きし、その後ゲートバルブ66を開ける。2枚のウェーハは、真空中で、ウェーハ搬送ロボット80によりロードロック室52内のウェーハポート70の下側の2つのスロットに移載される。このとき、ウェーハポート70の上側2つのスロットには未処理のウェーハが搭載されているので、2枚の未処理のウェーハは、ウェーハ搬送室54内のウェーハ搬送ロボット80により反応処理室56内のサセアタ90にすぐに搬送される。

【0105】このようにして、予め、未処理のウェーハをロードロック室52に供給して、真空雰囲気に保持しておくことにより、未処理のウェーハの搬送時間が短縮できる。

【0106】その後、ゲートバルブ64を閉じ、ロードロック室52内を窒素等で大気圧にし、ここでウェーハを所定の温度になるまで冷却する。

【0107】その後、外ゲートバルブ62を開け、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20のウェーハ搬送機23によってウェーハはカセット40内に移載される。

【0108】所定枚数のウェーハがカセット40内に搬入されると、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20のカセット搬送機21によってカセット10が下側に運ばれ、その後、カセットローダ室10から搬出される。

【0109】図10は、本発明の本発明の第1乃至第2の実施の形態において使用するカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20を説明するための概略斜視図である。

【0110】ベース25、26上にカセット搬送機21とウェーハ搬送機23が設けられており、カセット搬送機21とウェーハ搬送機23とは、独立に矢印の方向に

40 平行移動することができる。カセット搬送機21はカセット搬送アーム22を備えており、カセット搬送アーム22の先に取り付けられたカセットホルダー27上にカセット10を載置してカセット10を搬送する。ウェーハ搬送機23は複数のツィーザ24を備えており、このツィーザ24上にウェーハをそれぞれ搭載してウェーハを搬送する。

【0111】図11は、本発明の本発明の第1乃至第2の実施の形態において使用するカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20のピッチ変換機構を説明するための図であり、図11Aは側面図、図11Bは図11AのY-

Y線より見た背面図である。

【0112】本実施の形態では、ウェーハ搬送機23は、5枚のツィーザ241乃至245を備えている。ツィーザ241はブロック260と一体化されている。ツィーザ242、243、244、245にはナット232、233、234、235がそれぞれ固定されている。ナット232とナット234はねじ軸210と噛み合わせられておりナット232とナット234はねじ軸210とそれそれぞれボールねじを構成している。ナット233とナット235はねじ軸211と噛み合わせられておりナット233とナット235はねじ軸211とそれぞれボールねじを構成している。ねじ軸210の上端およびねじ軸211の上端はモータ220と歯車機構(図示せず。)を介して接続されており、ねじ軸210の下端およびねじ軸211の下端は、ブロック250に回転自在に取り付けられている。ブロック250とブロック260にはナット270が取り付けられており、ナット270はねじ軸280と噛み合って設けられており、ナット270とねじ軸280とによりボールねじを構成している。ねじ軸280が回転すると、ナット270が左右に動いてツィーザ241乃至245を左右に移動させる。

【0113】ナット232と噛み合っているねじ軸210の領域212には1倍ピッチのねじが形成されており、ナット233と噛み合っているねじ軸211の領域213には2倍ピッチのねじが形成されており、ナット234と噛み合っているねじ軸210の領域214には3倍ピッチのねじが形成されており、ナット235と噛み合っているねじ軸211の領域215には4倍ピッチのねじが形成されている。また、ブロック250とブロック260との間の上下方向の相対位置は変化しない。モータ220によってねじ軸210とねじ軸211を回転させると、ブロック250とブロック260とは昇降せず、ナット232は所定の距離昇降し、ナット233はナット232の2倍の距離昇降し、ナット234はナット232の3倍の距離昇降し、ナット235はナット232の4倍の距離昇降する。従って、ツィーザ241は昇降せず、ツィーザ242は所定の距離昇降し、ツィーザ243はツィーザ242の2倍の距離昇降し、ツィーザ244はツィーザ242の3倍の距離昇降し、ツィーザ245はツィーザ242の4倍の距離昇降する。その結果、ツィーザ241乃至245間のピッチを均等に保ったまま、ツィーザ241乃至245間のピッチを変換できる。

【0114】反応処理室56において、例えば、プラスチックを利用せずに成膜等を行う場合にあっては、占有床面積を小さくするためのウェーハ5を積層してウェーハ5の処理を行うことが行われるが、この場合には、複数枚のウェーハ5の間隔を反応基板処理室56内でのガスの流れ等を考慮して膜厚均一性等を維持することができる

間隔にする必要がある。一方、工場内においてウェーハ5を搬送する場合には、カセット等が用いられることが多いが、通常は、このカセットの溝間隔は上記膜厚均一性等を維持することができる間隔とは異なっている。そのため、いずれかの場所でウェーハ5間のピッチを変換することが必要となる。

【0115】従って、上述のように、カセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20がピッチ変換機構を備えるようにすれば、大気圧下でピッチを可変とでき、真空中での10場合と比較すれば構造が簡単であり、安価に製造でき、また、パーティクルの発生を抑えることができる。そして、このようにカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボット20でウェーハ5間のピッチを変換できるので、ウェーハ搬送ロボットはピッチ可変な構造とする必要がなくなり、その構造が簡単となり、安価に製造できる。なお、この場合には、ロードロック室52のウェーハポート70に保持されるウェーハ5間の間隔を反応処理室56内でのウェーハ5間の間隔と実質的に等しくしておくことが好ましい。

20 【0116】(第2の実施の形態)図12は、本発明の第2の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための図であり、図12Aは平面図、図12Bは断面図である。

【0117】上述した第1の実施の形態においては、ロードロック室52と搬送室54との間にゲートバルブ64を設けたが、本実施の形態においては、そのようなゲートバルブを設けず、ウェーハポート70とウェーハ搬送ロボット80を同一のロードロック兼搬送室58に設けた点が第1の実施の形態と異なるが他の点は同様である。

30 【0118】
【発明の効果】本発明によれば、基板の処理効率が高く、スループットに優れた基板処理装置が得られる。

【0119】また、複数のモジュールを互いに離間して鉛直方向に積み重ね、複数のモジュールのそれぞれを取り外し可能に基板搬送部に取り付けることにより、装置の稼働効率が高く、しかも、占有面積が小さくメンテナンス領域が小さい基板処理装置が得られる。

【図面の簡単な説明】
40 【図1】本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための図であり、図1Aは平面図、図1Bは断面図である。

【図2】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための断面図である。

【図3】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための断面図である。

【図4】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための平面図である。

【図5】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための平面図である。

【図6】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための平面図である。

【図7】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための断面図である。

【図8】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための平面図である。

【図9】本発明の本発明の第1の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置におけるロードロック室を説明するための断面図である。

【図10】本発明の本発明の第1乃至第2の実施の形態において使用するカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボットを説明するための概略斜視図である。

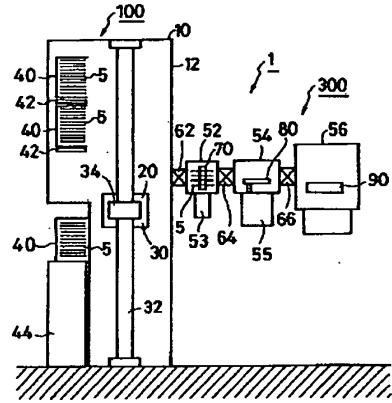
【図11】本発明の本発明の第1乃至第2の実施の形態において使用するカセット搬送兼ウェーハ搬送ロボットのピッチ変換機構を説明するための図であり、図11Aは側面図、図11Bは図11AのY-Y線より見た背面

【図12】本発明の第2の実施の形態の半導体ウェーハ処理装置を説明するための図であり、図12Aは平面図、図12Bは断面図である。

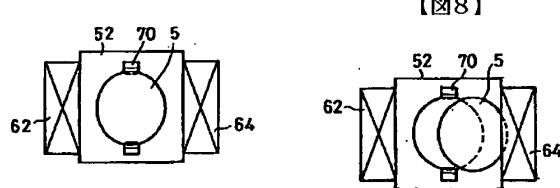
【図13】従来の半導体ウェーハ処理装置を説明するための平面図である。

【符号の説明】

【図2】



【図6】

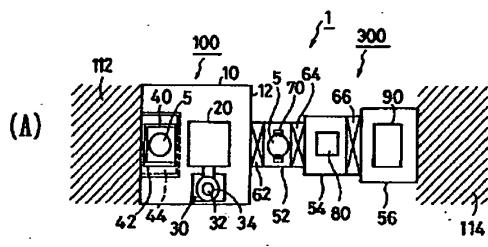


【図8】

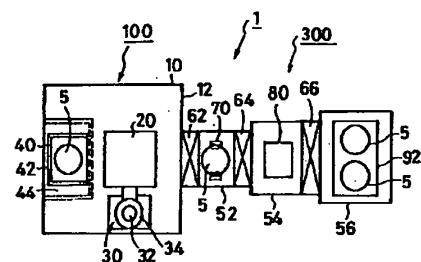
【図3】

【図3】

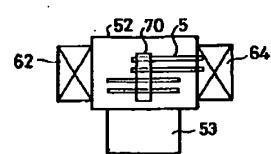
【図1】



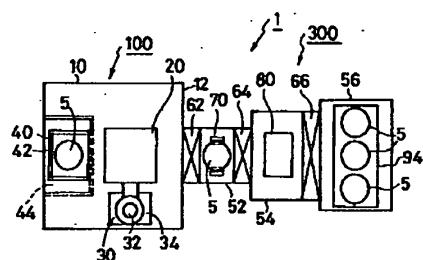
【図4】



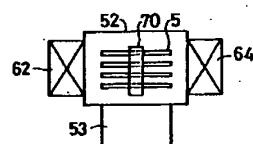
【図9】



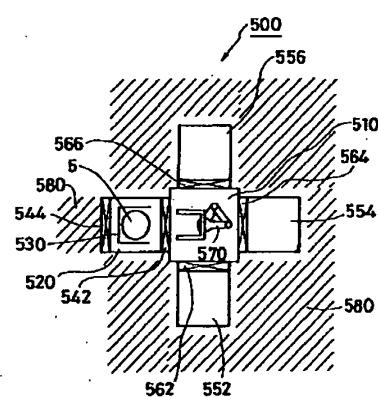
【図5】



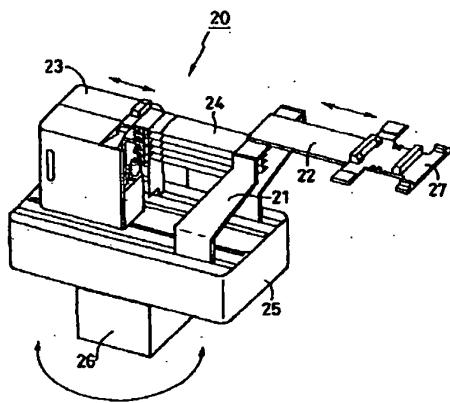
【図7】



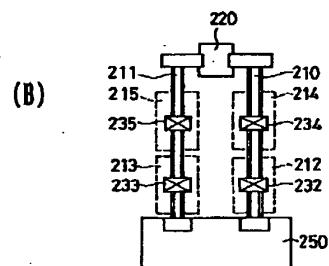
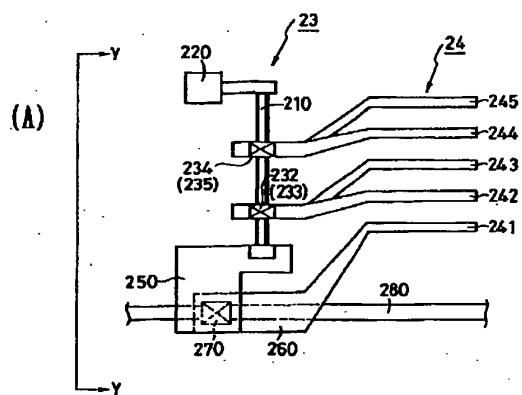
【図13】



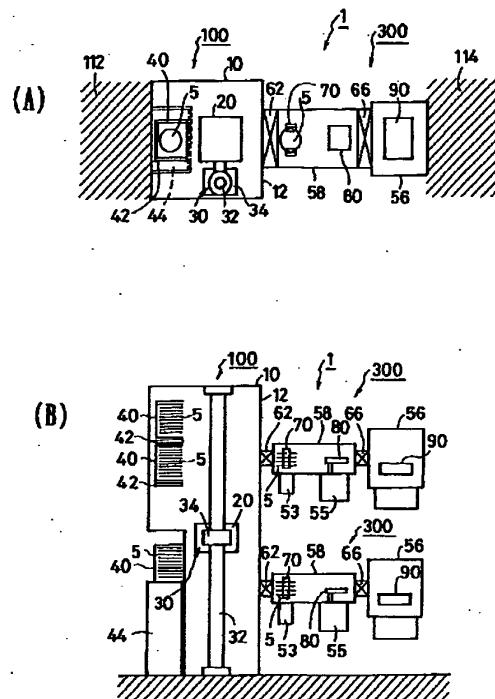
【図10】



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 竹下 光徳
東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
電気株式会社内
(72)発明者 田中 勉
東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
電気株式会社内

(72)発明者 鈴木 貞之
東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
電気株式会社内
(72)発明者 野村 慎一
東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
電気株式会社内